

## NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY

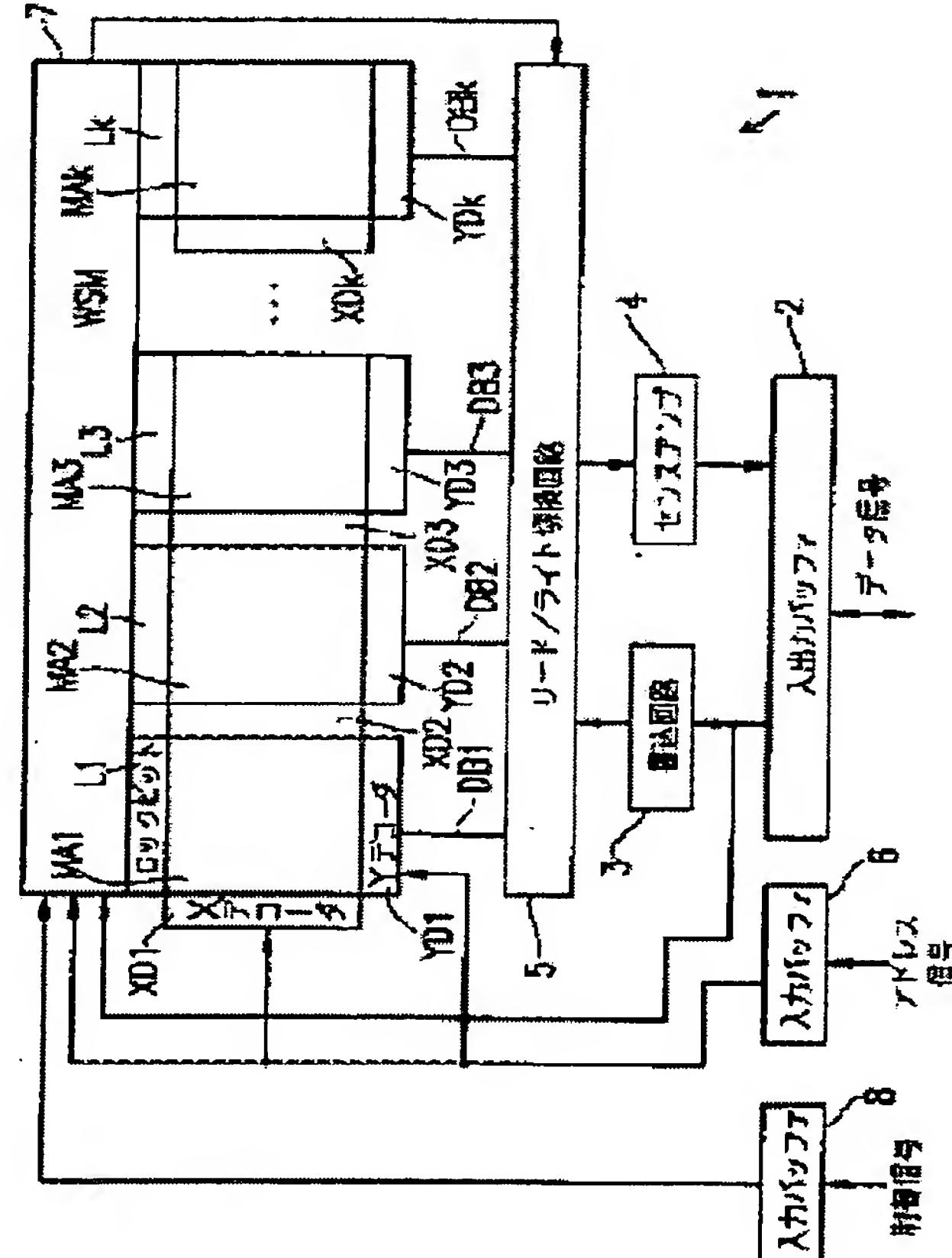
**Patent number:** JP2001283594  
**Publication date:** 2001-10-12  
**Inventor:** TAKADA SHIGEKAZU  
**Applicant:** SHARP KK  
**Classification:**  
 - international: G11C16/10; G11C16/22; G11C16/26; G11C16/06;  
 (IPC1-7): G11C16/02; G06F12/14; H01L21/8247;  
 H01L27/115; H01L29/788; H01L29/792  
 - european: G11C16/10; G11C16/22; G11C16/26  
**Application number:** JP20000092522 20000329  
**Priority number(s):** JP20000092522 20000329

**Also published as:**  
 EP1143455 (A2)  
 US6469928 (B2)  
 US2001036105 (A)  
 EP1143455 (A3)

[Report a data error](#)

### Abstract of JP2001283594

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To prevent information of a memory cell array block from being rewritten or erased erroneously or illegally.  
**SOLUTION:** In a non-volatile semiconductor memory in which read-out operation from an arbitrary memory cell array block MA and write-in or erase operation of the other memory cell array block MA can be performed simultaneously on one chip, the device has a security function against illegal rewriting after data are written once, while the device can be provided with a memory cell array block MA storing the information requiring no rewrite.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-283594

(P 2001-283594 A)

(43) 公開日 平成13年10月12日 (2001.10.12)

(51) Int.CI.

G11C 16/02  
G06F 12/14  
H01L 21/8247  
27/115  
29/788

識別記号

310

F I

G06F 12/14  
G11C 17/00  
H01L 27/10  
29/78

310  
601  
434  
371  
5F101

テマコード (参考)

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全8頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願2000-92522 (P 2000-92522)

(22) 出願日

平成12年3月29日 (2000.3.29)

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 高田 栄和

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ  
ヤープ株式会社内

(74) 代理人 100078282

弁理士 山本 秀策

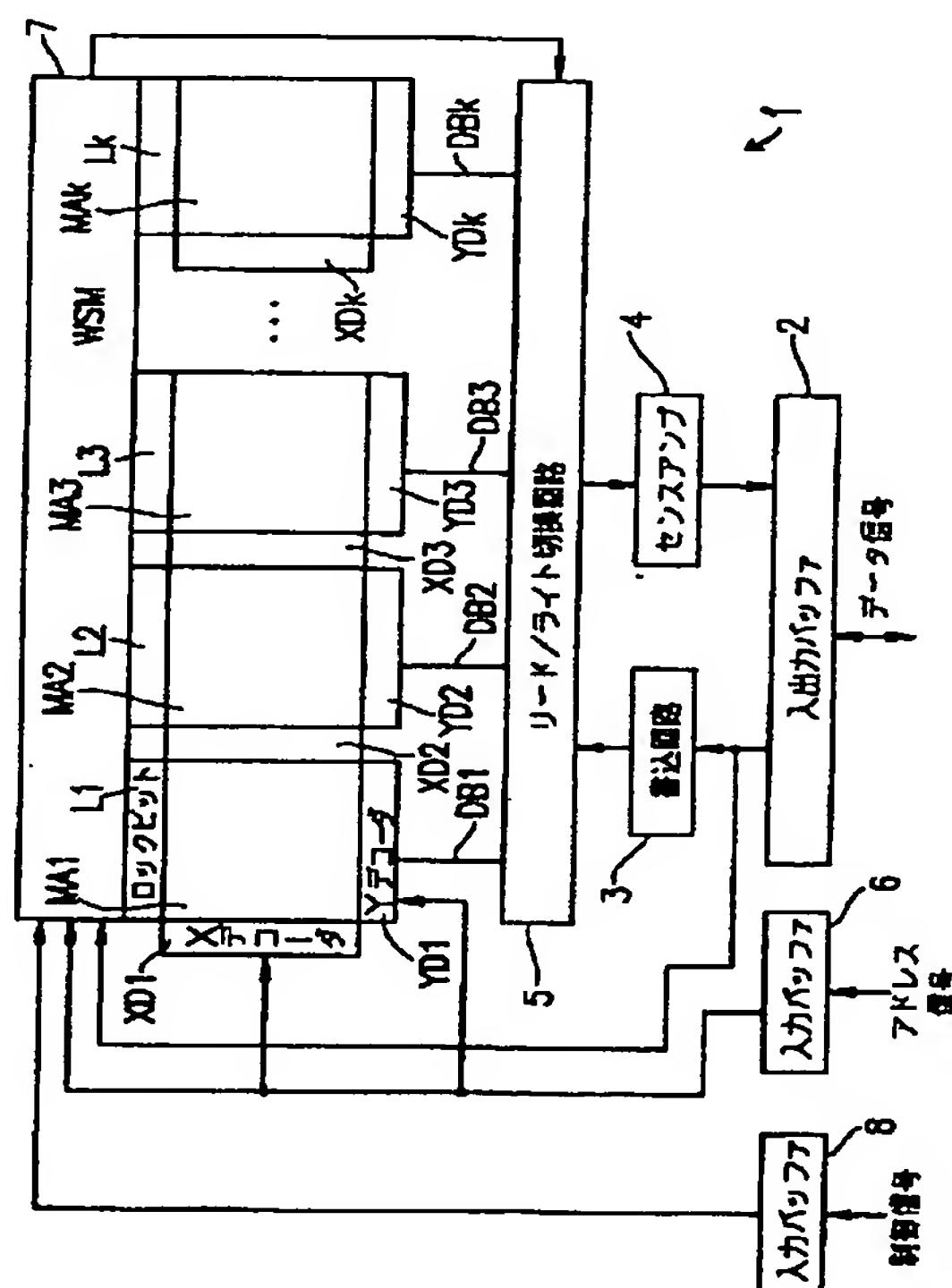
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】不揮発性半導体記憶装置

(57) 【要約】

【課題】メモリセルアレイブロックを間違ってまたは不正にする情報の書換えや消去を防止する。

【解決手段】任意のメモリセルアレイブロックMAからの読み出し動作と、他のメモリセルアレイブロックMAの書き込みまたは消去動作とを1チップ上において同時に実行できる不揮発性半導体記憶装置1において、ライトステートマシン(WSM)7によってブロックロック設定部Lにブロックロック(ロックビット)を設定することで、1回データを書き込んだ後の不正書き換えに対するセキュリティ機能を有すると共に書き換えを必要としない情報を格納するメモリアレイブロックMAを設けることができる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のメモリセルアレイブロックのうちの任意のメモリセルアレイブロックに対する情報の書き込み動作または消去動作と、前記任意のメモリセルアレイブロックとは別の任意のメモリセルアレイブロックに対する読み出し動作とを同時に実行可能とする不揮発性半導体記憶装置において、

前記複数のメモリセルアレイブロック毎に、情報の書き込みおよび消去動作を禁止するブロックロック設定手段が設けられ、少なくとも一つのブロックロック設定手段にブロックロックが設定されている不揮発性半導体記憶装置。

【請求項2】 前記ブロックロック設定手段は、情報の書き込み動作および消去動作禁止用のロック情報を設定可能とするフローティングゲート型MOSトランジスタとラッチ型回路との何れかで構成されている請求項1記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項3】 任意のメモリセルアレイブロックへのデータの読み出し動作と書き込みまたは消去動作を実行すると共に、所定のメモリセルアレイブロックのブロックロック設定手段に対して、情報の書き込みおよび消去動作を禁止するロック情報を設定可能とするメモリ動作およびロック設定制御手段が設けられた請求項1または2記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項4】 前記メモリ動作およびロック設定制御手段からの制御信号によって制御され、任意のメモリセルアレイブロックのデータバスと情報読出用出力端の接続制御を可能とすると共に、前記任意のメモリセルアレイブロックとは別のメモリセルアレイブロックのデータバスと情報書込用入力端の接続制御を可能とする接続制御手段が設けられている請求項3記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項5】 前記ブロックロック設定手段によりブロックロックが設定されているメモリセルアレイブロックに対しては、セキュリティが必要な情報および情報の書き換えを必要としない情報が格納されている請求項1～4の何れかに記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項6】 電気的に情報の書き込み、消去および読み出しが可能な不揮発性メモリトランジスタがマトリクス状に配列され、同一行のトランジスタのコントロルゲートが共通接続されてワード線を構成し、同一列のトランジスタのドレインが共通接続されてビット線を構成し、全てのトランジスタのソースが共通接続された前記メモリセルアレイブロックであって、

入力アドレス信号の行選択信号部分の信号値に応じて、所定のワード線選択信号を出力する行デコーダと、入力アドレス信号の列選択信号部分の信号値に応じて、前記ビット線を選択的にデータバスに接続する列デコーダとを備えた前記メモリセルアレイブロックが、单一集積回路上に3個以上配設されている請求項1～5の何れかに

記載の不揮発性半導体記憶装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電気的に情報の書き込みまたは消去動作と、情報の読み出し動作とを同時に実行可能とする不揮発性半導体記憶装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】通常、フラッシュEEPROM（ブロッケーブロック消去型1チップ・フラッシュメモリ）では、任意のメモリセルブロックへの書き込みまたは消去動作が行われるときに、それ以外のメモリセルブロックには何らアクセスが為されていない。書き込み動作には、通常数マイクロ秒～10マイクロ秒の時間を要する一方、消去動作には数100ミリ秒～1秒程度の長い時間を要している。近年のマイクロプロセッサの高速化が進む中で、フラッシュEEPROMのデータの書き込み動作または消去動作に要する時間が長いことが課題とされている。

【0003】このような課題を解決するために、任意のメモリセルブロックへの書き込み動作または消去動作が

20 実行されている間に、他のメモリセルブロックからデータを読み出すことができる技術が、特開平6-180999号公報「同時読み出し／書き込み機能付きフローティングゲート非揮発型メモリ及びこれを備えたマイクロプロセッサ」、特開平7-281952号公報「不揮発性半導体記憶装置」、特開平5-54682号公報「不揮発性半導体メモリ」および特開平10-144086号公報「不揮発性半導体記憶装置」などに開示されている。当出願人から既に出願されている特開平10-144086「不揮発性半導体記憶装置」について図3を用いて以下詳細に説明する。

【0004】図3は従来の不揮発性半導体記憶装置の回路構成を示すブロック図である。図3において、不揮発性半導体記憶装置40は、ブロッケーブロック消去型1チップ・フラッシュメモリで構成されており、2つの書き回路41、42がそれぞれ2系統のデータバスDB-1、DB-2をそれぞれ介して各列デコーダYD（YD1、…、YDk）にそれぞれ接続されている。これらの各列デコーダYDはそれぞれ2系統のデータバスDB-1、DB-2を介して各センサアンプ回路43、44に

40 それぞれ接続されている。各列デコーダYDにそれぞれ対応するように各メモリセルアレイブロックMA（MA1、MA2、…、MAk）がそれぞれ配設されている。これらのメモリセルアレイブロックMA全体に対してその両側に行デコーダXD1、XD2が設けられ、メモリセルアレイブロックMAのそれぞれの間にスイッチ回路SW（SW1～SWk-1）が介装されて各メモリセルアレイブロックMAそれを直列に連結している。

【0005】書き回路41、42は、データ書き込み時に、データバスDB-1、DB-2に対して所定の書き

込み用高電圧VPPを印加するものである。

【0006】データバスDB-1, DB-2は、データの読み出し動作と書き込み動作を異なるメモリセルアレイブロックMAで同時に実行させるために2系統設けられている。

【0007】センスアンプ回路43, 44はそれぞれ、データ読み出し時に、データバスDB-1, DB-2の電流をセンスし、それを増幅して外部にデータ出力するものである。

【0008】列デコーダYDは、各メモリセルアレイブロックMAに対するデータ書き込みまたは読み出し時に、入力アドレス信号の列選択信号部分の信号値に応じて、選択されたビット線を、データバスDB-1またはDB-2に逐一的に接続するものである。

【0009】行デコーダXD1, XD2のうち一方の行デコーダXD1は、メモリセルアレイブロックMA1の各ワード線に接続され、他方の行デコーダXD2はメモリセルアレイブロックMAkの各ワード線に接続されており、入力アドレス信号の行選択信号の信号値に応じて、所定のワード線選択信号を出力するものである。

【0010】各スイッチ回路SWはそれぞれ、そのスイッチング素子群が各ブロックのワード線間に介装されている。各スイッチ回路SWのスイッチング素子群は、それぞれ共通接続されてオン／オフ制御されるようになっている。このように、各メモリセルアレイブロックMA間にスイッチング素子群を配置することで、メモリセルアレイブロックMAを、2つの独立した左右の領域に分離（スイッチング素子のオフ）し、各々の独立した左右領域に対して、行デコーダXD1, XD2によって両側からワード線を選択することで、読み出し動作と書き込みを同時に実行させることができるようになっている。また、消去動作を含めて、読み出し動作と書き込みまたは消去動作とを同時実行させることも可能である。また、2つのメモリセルアレイブロックの独立した領域への書き込み動作を同時に実行することも可能であるし、独立に動作させるメモリセルアレイブロックの領域を全く任意に設定したり変更したりすることも可能である。

【0011】各メモリセルアレイブロックMAはそれぞれ、後述する共通ソースに、書き込み時、消去時および読み出し時の所定電圧（書き込み時および読み出し時は接地電圧、消去時は高電圧VHH）が印加され、また、それぞれのビット線には書き込み時は高電圧VPPが印加されるようになっている。

【0012】メモリセルアレイブロックMAはそれぞれ、図4に示すように、不揮発性メモリトランジスタとしてフローティングゲート型MOSトランジスタTrがマトリクス状に配列されて構成されている。同一行のトランジスタTrのコントロールゲートGが共通接続されてワード線Wを構成し、同一列のトランジスタTrのドレインDが共通接続されてビット線Bを構成し、さらに、

マトリクスを構成する全てのトランジスタTrのソースSが共通接続されて共通ソースを構成している。

【0013】このフローティングゲート型MOSトランジスタTrは、図5に示すように、コントロールゲートGの下方にフローティングゲートFを有しており、書き込み動作は、ドレインDの近傍からフローティングゲートFへのチャンネルホットエレクトロン注入により行い、消去動作は、図6に示すようにフローティングゲートFからソースSへのファウラーノードハイム電流によるトンネル消去により行うようになっている。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、一般に不揮発性メモリに共通する問題であるが、何れのメモリセルアレイブロックMAへの書き込み動作または消去動作も可能であったため、そのメモリセルアレイブロックMAが間違ってまたは不正に書き換えられてしまう虞があった。

【0015】本発明は、上記従来の事情に鑑みて為されたもので、メモリセルアレイブロックが間違ってまたは不正に書き換えられてしまうことを防止することができる不揮発性半導体記憶装置を提供することを目的とする。

【0016】

【課題を解決するための手段】本発明の不揮発性半導体記憶装置は、複数のメモリセルアレイブロックのうちの任意のメモリセルアレイブロックに対する情報の書き込み動作または消去動作と、任意のメモリセルアレイブロックとは別の任意のメモリセルアレイブロックに対する読み出し動作とを同時に実行可能とする不揮発性半導体記憶装置において、複数のメモリセルアレイブロック毎に、情報の書き込みおよび消去動作を禁止するブロックロック設定手段が設けられ、少なくとも一つのブロックロック設定手段にブロックロックが設定されているものである。

【0017】この構成により、任意のメモリセルアレイブロックのブロックロック設定手段にブロックロック（ロックビット）が設定されているので、ブロックロックが設定されたメモリセルアレイブロックに対しては、間違ってまたは不正に行われる情報の書き換え動作や消去動作が防止される。

【0018】また、好ましくは、本発明の不揮発性半導体記憶装置において、ブロックロック設定手段は、情報の書き込み動作および消去動作禁止用のロック情報を設定可能とするフローティングゲート型MOSトランジスタとラッチ型回路との何れかで構成されている。

【0019】この構成により、ブロックロック設定手段を例えばフローティングゲート型MOSトランジスタやラッチ型回路で構成すれば、ブロックロック設定手段を簡単に構成することができる。

【0020】また、好ましくは、本発明の不揮発性半導

体記憶装置において、任意のメモリセルアレイブロックへのデータの読み出し動作と書き込みまたは消去動作を実行すると共に、所定のメモリセルアレイブロックのブロックロック設定手段に対して、情報の書き込みおよび消去動作を禁止するロック情報を設定可能とするメモリ動作およびロック設定制御手段が設けられている。

【0021】この構成により、このメモリ動作およびロック設定制御手段によって、所望のメモリセルアレイブロックに対して、ブロックロック設定手段に対するブロックロックの設定が容易に為される。また、メモリ動作およびロック設定制御手段によって任意のメモリセルアレイブロックへの情報の書き込み動作を実行した後に、その書き込み動作を実行した所定のメモリセルアレイブロックのブロックロック設定手段に対して、情報の書き込みおよび消去動作を禁止するロック情報を設定すれば、任意のメモリセルアレイブロックに情報を1回書き込んだ後に、その情報を書き込んだメモリセルアレイブロックに対して不正な書込動作や消去動作ができず、この書き込んだ情報は保護されると共に読み出し動作のみ可能とすることができる。

【0022】さらに、好ましくは、本発明の不揮発性半導体記憶装置において、メモリ動作およびロック設定制御手段からの制御信号によって制御され、任意のメモリセルアレイブロックのデータバスと情報読出用出力端の接続制御するときに、前記任意のメモリセルアレイブロックとは別のメモリセルアレイブロックのデータバスと情報書込用入力端の接続制御可能とする接続制御手段が設けられている。

【0023】この構成により、例えば同時に選択された2つのメモリセルアレイブロックのうちの一方への書き込みまたは消去動作を実行している間に、他方が読み出し動作を実行することも可能となる。また、例えば、ブロックロックが設定されているメモリセルアレイブロック以外の任意のメモリセルアレイブロックへの書き込み動作が実行されている間に、ブロックロックが設定されているメモリセルアレイブロックからの読み出し動作を実行することも可能となる。

【0024】さらに、好ましくは、本発明の不揮発性半導体記憶装置において、ブロックロック設定手段によりブロックロックが設定されているメモリセルアレイブロックに対しては、セキュリティが必要な情報および情報の書き換えを必要としない情報が格納されている。

【0025】この構成により、メモリアレイブロックに記憶されたセキュリティ機能または書き換えを必要としない情報に対して、間違ってまたは不正に情報の書き換え動作や消去動作が行われないので安全である。

【0026】さらに、好ましくは、本発明の不揮発性半導体記憶装置において、電気的に情報の書き込み、消去および読み出しが可能な不揮発性メモリトランジスタがマトリクス状に配列され、同一行のトランジスタのコン

トロールゲートが共通接続されてワード線を構成し、同一列のトランジスタのドレインが共通接続されてピット線を構成し、全てのトランジスタのソースが共通接続された前記メモリセルアレイブロックであって、入力アドレス信号の行選択信号部分の信号値に応じて、所定のワード線選択信号を出力する行デコーダと、入力アドレス信号の列選択信号部分の信号値に応じて、ピット線を選択的にデータバスに接続する列デコーダとを備えた前記メモリセルアレイブロックが、单一集積回路上に3個以上配設されている。

【0027】この構成により、不揮発性メモリトランジスタがマトリクス状に配列されたメモリセルアレイブロックに、間違ってまたは不正に書き換えたり消去するのを防止する本発明の構成を容易に適用可能である。また、任意のメモリセルアレイブロックからの情報の読み出し動作と、その任意のメモリセルアレイブロックとは別のメモリセルアレイブロックの書き込み・消去動作とを1チップ上において同時に実行させることが可能となる。

#### 【0028】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

【0029】図1は、本発明の一実施形態における不揮発性半導体記憶装置の構成を示すブロック図である。図1において、不揮発性半導体記憶装置1は、データ信号が入出力される入出力バッファ2と、入出力バッファ2の出力端がデータ書込用入力端に接続された書込回路3と、入出力バッファ2の入力端がデータ読出用出力端に接続されたセンスアンプ回路4と、書込回路3のデータ書込用出力端が接続されると共にセンスアンプ回路4のデータ読出用入力端が接続された接続制御手段としてのリード/ライト切換回路5と、リード/ライト切換回路5とデータバスDB(DB1, ..., DBk)をそれぞれ介して接続された列デコーダYD(YD1, ..., YDk)と、各列デコーダYDにそれぞれ対応して配設された各メモリセルアレイブロックMA(MA1, MA2, ..., MAK)と、各メモリセルアレイブロックMAにそれぞれ対応して配設された行デコーダXD(XD1, ..., XDk)とを備えており、列デコーダYDおよび行デコーダXDには、メモリセルを特定するためのアドレス信号が入力される入力バッファ6が接続されている。

【0030】書込回路3は、データ書き込み時に、リード/ライト切換回路5に対して書き込み信号(所定の書き込み用高電圧VPP)を出力するものである。

【0031】センスアンプ回路4は、データ読み出し時に、リード/ライト切換回路5からの読み出し電流をセンスし、それを増幅して入出力バッファ2に出力するものである。

【0032】リード/ライト切換回路5は、後述するラ

イトステートマシン7からのメモリ動作制御信号によって制御され、データの読み出し動作と書き込みまたは消去動作のために接続制御を行うものである。例えば、リード／ライト切換回路5は、データの読み出し動作と書き込み動作を同時に実行するべく、任意のメモリセルアレイブロックMAのデータバスDBとセンスアンプ回路4との間および、他の任意のメモリセルアレイブロックMAのデータバスDBと書き回路3との間を接続制御することを可能とするものである。

【0033】列デコーダYDは、その出力端がそれぞれメモリセルアレイブロックMAのピット線にそれぞれ接続されており、各メモリセルアレイブロックMAに対する入力アドレス信号の列選択信号部分の信号値に応じて、選択されたデータ入出力用のピット線をそれぞれのデータバスDB1、…、DBkに接続するようになっている。

【0034】行デコーダXDは、その出力端がそれぞれメモリセルアレイブロックMAのワード線にそれぞれ接続されており、各メモリセルアレイブロックMA(MA1、…、MAk)に対するデータ書き込みおよび読み出し時に、入力アドレス信号の行選択信号部分の信号値に応じて、所定のワード線選択信号(トランジスタをオンオフ制御する信号)を出力するようになっている。

【0035】複数の(3つ以上)のメモリセルアレイブロックMAはそれぞれ、図4の場合と同様の構成であり、不揮発性メモリトランジスタとしてフローティングゲート型MOSトランジスタTrがマトリクス状に配列され、同一行のトランジスタTrのコントロールゲートGが共通接続されてワード線Wを構成し、同一列のトランジスタTrのドレインDが共通接続されてピット線Bを構成し、さらに、マトリクスを構成する全てのトランジスタTrのソースSが共通接続されて共通ソースを構成するものである。

【0036】このフローティングゲート型MOSトランジスタTrはコントロールゲートGの下方位置にフローティングゲートFを有し、書き込み動作は、図5に示すようにドレインDの近傍からフローティングゲートFへのチャンネルホットエレクトロン注入により行い、消去動作は、図6に示すようにフローティングゲートFからソースSへのファウラーノードハイム電流によるトンネル消去により行うように構成している。

【0037】また、不揮発性半導体記憶装置1は、メモリ動作およびロック設定制御手段としてのライトステートマシン(WSM:Write State Machine)7と、ブロックロック設定手段としてのブロックロック設定部L(L1、…、Lk)とを有しており、ライトステートマシン7には、データが入力される入力バッファ2と、メモリセルを特定するアドレス信号が入力される入力バッファ6と、メモリ動作およびロック設定用の各種制御信号が入力される入力バッファ8とが接続されてい

る。制御信号としては、ブロックロックコマンド信号、ブロックロックアドレス信号およびメモリコマンド信号(リード／ライト信号および消去信号など)などがある。外部から、後述するが、書き込み可能でかつ消去不可能なメモリセルアレイブロック領域(以下、OTP領域という)の読み出し動作および、書き込みまたは消去動作を実行すると共に書き込みまたは消去動作を禁止するロック情報を設定するためのブロックロックコマンド信号には、OTP領域以外のメモリセルアレイブロックMAへの読み出し、書き込みまたは消去用のコマンド信号(リード／ライト信号および消去信号など)とは異なったコマンド信号を用いる。

【0038】ブロックロック設定部L(L1、…、Lk)は、各メモリセルアレイブロックMA毎に対応して設けられており、上記フローティングゲート型MOSトランジスタTrを用いたメモリセルと同様の構造によるもので、そこに書き込みおよび消去を禁止するためのロックビットによるロック情報の設定が可能になっている。

【0039】ライトステートマシン7は、所定の命令に基づいて小規模CPU(中央演算処理装置)としてメモリ動作およびロック設定動作を行うものである。ライトステートマシン7は、メモリ動作として、メモリセルアレイブロックMAへのデータの書き込み動作やブロック単位での消去動作の他、読み出し動作を実行するものである。また、ライトステートマシン7は、ロック設定動作として、所定のメモリセルアレイブロックMAのブロックロック設定部Lに対して、情報の書き込みおよび消去動作を禁止するロックビットによるロック情報の設定を可能とするようになっている。特定のメモリセルアレイブロックMAに対して1回だけデータを書き込み可能でかつ消去不可能とするメモリセルアレイブロック領域(以下、OTP領域という)に設定することができるようになっている。このOTP領域は、各メモリセルブロックMAの内の任意の1つ以上を持つことを特徴しており、OTP領域意外のメモリセルブロックMAに対しては、書き込み動作および消去動作を行うことができるようになっている。

【0040】上記構成により、以下その動作を説明する。まず、入出力バッファ5には書き込むべきデータ信号が入力される。このデータ信号は書き回路3を介してリード／ライト切換回路5に入力される。このとき、入力バッファ6を介してメモリセルを特定するアドレス信号が列デコーダYDおよび行デコーダXDに入力される。また、ライトステートマシン7には、アドレス信号およびデータ信号の他に、メモリ動作用の各種制御信号としてリード／ライト信号が入力される。

【0041】列デコーダYDでは、入力アドレス信号の列選択信号部分の信号値に応じて、選択された例えば2つのメモリセルアレイブロックMA, MA'の所定のビ

ット線をデータバスDBに接続し、行デコーダXDでは、入力アドレス信号の行選択信号部分の信号値に応じて、選択されたメモリセルアレイブロックMA, MA'の所定のワード線選択信号を出力する。

【0042】ライトステートマシン7は、リード/ライト信号を解読してリード/ライト切換回路5を制御し、リード/ライト切換回路5により例えばデータの読み出し動作と書き込み動作を同時に実行する。即ち、リード/ライト切換回路5によって、例えば1つのメモリセルアレイブロックMAのデータバスDBとセンスアンプ回路4とを接続することで、そのメモリセルアレイブロックMAからデータが読み出されると同時に、もう1つの別のメモリセルアレイブロックMA'のデータバスDBと書込回路3とを接続することで、そのメモリセルアレイブロックMAへのデータが書き込みが行われる。

【0043】次に、以上のようにして1回だけデータを書き込んだ後、図2に示すようにステップS1でライトステートマシン7にロックロックコマンド信号を入力する。ライトステートマシン7は、ステップS2でロックロックコマンド信号かどうかを判定し、ステップS2でロックロックコマンド信号であれば、ステップS3でOTP領域のロックロック設定部Lにロックビットのセットを行う。つまり、ライトステートマシン7に、アドレス信号およびデータ信号の他に、ロックロック設定用の各種制御信号としてロックロックコマンド信号およびロックロックアドレス信号などが入力される。ライトステートマシン7は、ロックロックコマンド信号外部からロックロックコマンドが入力されると、ロックロックコマンド信号およびロックロックアドレス信号に従って該当メモリセルアレイブロックMAのロックロック設定部Lにロック情報を設定する。ライトステートマシン7が、ステップS2でロックロックコマンド信号でないと判定したら、ステップS4でロックビットが「1」かどうかを判定し、「1」であればステップS1に戻り、「1」でなければ、次のステップS5で通常のメモリ動作に戻るように制御を行う。以後このロック状態が解除されるまで、このメモリセルアレイブロックMAの書き込み動作および消去動作が禁止されることになる。

【0044】このとき、OTP領域からのデータの読み出し動作は、他のメモリセルアレイブロックMAと同様、自由に行われる。また、他のメモリセルアレイブロックMAへの書き込み動作が実行されている間に、OTP領域からデータを読み出すことも可能である。したがって、2つのメモリアレイブロックMA, MA'の一方ではデータの書き込みまたは消去動作を実行し、他方ではセキュリティ情報または書き換えを必要としない情報の読み出しだけを実行することで、同時動作を実現することができる。しかも、1回だけデータを書き込んだ後、書き込みおよび消去が禁止され、データが保護され

る。

【0045】以上により本実施形態の不揮発性半導体記憶装置1によれば、任意のメモリセルアレイブロックMAからの読み出し動作と、他のメモリセルアレイブロックMAの書き込みまたは消去動作とを1チップ上において同時に実行できる不揮発性半導体記憶装置1において、ロックロック設定部Lにロックロックを設定することで、1回データを書き込んだ後の不正書き換えに対するセキュリティ機能を有すると共に書き換えを必要としない情報を格納するメモリアレイブロックMAを設けることができる。このようなロックロックが設定されたメモリセルアレイブロックMAに対して、間違つてまたは不正に行われる情報の書換動作や消去動作を防止することができる。この場合、他のメモリセルアレイブロックの書き込みまたは消去動作を実行している間に、セキュリティ機能を有するメモリアレイブロックからの読み出し動作を同時に実行することができる。

【0046】なお、本実施形態では、ロックロック設定部Lを、上記フローティングゲート型MOSトランジスタTrのメモリセルと同様のメモリセルで構成したが、上記メモリセル以外に、レジスタ中のビットを設定するラッチ型回路によっても実現することができる。

【0047】また、本実施形態では、各メモリセルアレイブロックMAはそれぞれ、後述する共通ソースに、書き込み時または消去時および、読み出し時の所定電圧（書き込み時および読み出し時は接地電圧、消去時は高電圧VHH）を選択的に印加するように構成したが、本発明はこれに限定されるものではなく、消去時に、上記トランジスタTrのコントロールゲートGに負電圧のワード線選択信号を印加し、上記共通ソースSに、接地電圧を印加する方式、または、フローティングゲートFとチャネル間で絶縁膜を介した面内で電荷を引き抜くチャネル消去型なども適用可能である。

#### 【0048】

【発明の効果】以上により請求項1によれば、任意のメモリセルアレイブロックのロックロック設定手段にロックロックが設定されているため、ロックロックが設定されたメモリセルアレイブロックに対して、間違つてまたは不正に行われる情報の書換動作や消去動作を防止することができる。

【0049】また、請求項2によれば、ロックロック設定手段を例えばフローティングゲート型MOSトランジスタやラッチ型回路で構成すれば、ロックロック設定手段を簡単に構成することができる。

【0050】さらに、請求項3によれば、メモリ動作およびロック設定制御手段によって、所望のメモリセルアレイブロックに対して、ロックロック設定手段に対するロックロックの設定を容易に行うことができる。また、メモリ動作およびロック設定制御手段によって任意

のメモリセルアレイブロックへの情報の書き込み動作を実行した後に、その書き込み動作を実行した所定のメモリセルアレイブロックのブロックロック設定手段に対して、情報の書き込みおよび消去動作を禁止するロック情報を設定すれば、任意のメモリセルアレイブロックに情報を1回書き込んだ後に、その情報を書き込んだメモリセルアレイブロックに対して不正な書き込み動作や消去動作ができない、この書き込んだ情報を保護することができると共に読み出し動作のみを行うことができる。

【0051】さらに、請求項4によれば、例えば同時に選択された2つのメモリセルアレイブロックのうちの一方への書き込みまたは消去動作を実行している間に、他方が読み出し動作を実行することもできる。また、例えば、ブロックロックが設定されているメモリセルアレイブロック以外の任意のメモリセルアレイブロックへの書き込み動作が実行されている間に、ブロックロックが設定されているメモリセルアレイブロックからの読み出し動作を実行することもできる。

【0052】さらに、請求項5によれば、メモリアレイブロックに記憶されたセキュリティ機能または書き換えを必要としない情報に対して、間違ってまたは不正に情報の書き換え動作や消去動作が行われないので安全である。このセキュリティ機能を有するメモリアレイブロックに、BIOS(ベイシック・インプット-アウトプット・システム: Basic Input-Output System)のように1回書き込めば、以後は書き換える必要のないデータを格納する目的にも用いることができる。

【0053】さらに、請求項6によれば、メモリセルとして不揮発性メモリトランジスタがマトリクス状に配列

されたメモリセルアレイブロックに、間違ってまたは不正に書き換えたり消去するのを防止する本発明の構成を容易に適用することができる。また、任意のメモリセルアレイブロックからの情報の読み出し動作と、その任意のメモリセルアレイブロックとは別のメモリセルアレイブロックの書き込みまたは消去動作とを1チップ上において同時に実行させることもできる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態における不揮発性半導体記憶装置の構成を示すブロック図である。

【図2】図1の不揮発性半導体記憶装置における書込／消去禁止動作を示すフローチャートである。

【図3】従来の不揮発性半導体記憶装置の回路構成を示すブロック図である。

【図4】図3のメモリセルアレイブロックの回路図である。

【図5】書き込み動作を示す不揮発性メモリトランジスタの構成図である。

【図6】消去動作を示す不揮発性メモリトランジスタの構成図である。

#### 【符号の説明】

1 不揮発性半導体記憶装置

5 リード／ライト切換回路

7 ライトステートマシン (WSM)

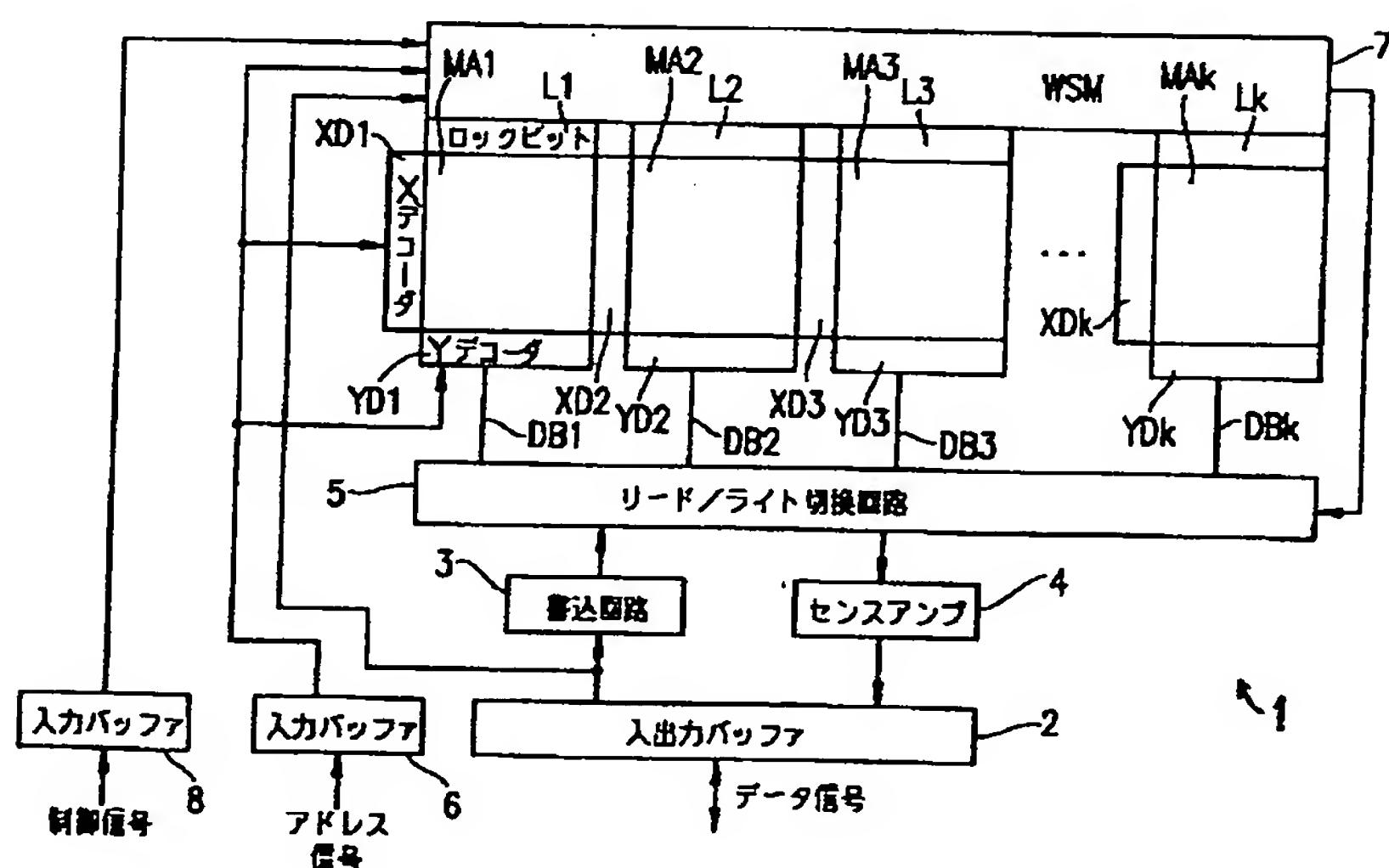
YD (YD<sub>1</sub>, …, YD<sub>k</sub>) 列デコーダ

MA (MA<sub>1</sub>, MA<sub>2</sub>, …, MA<sub>k</sub>) メモリセルアレイブロック

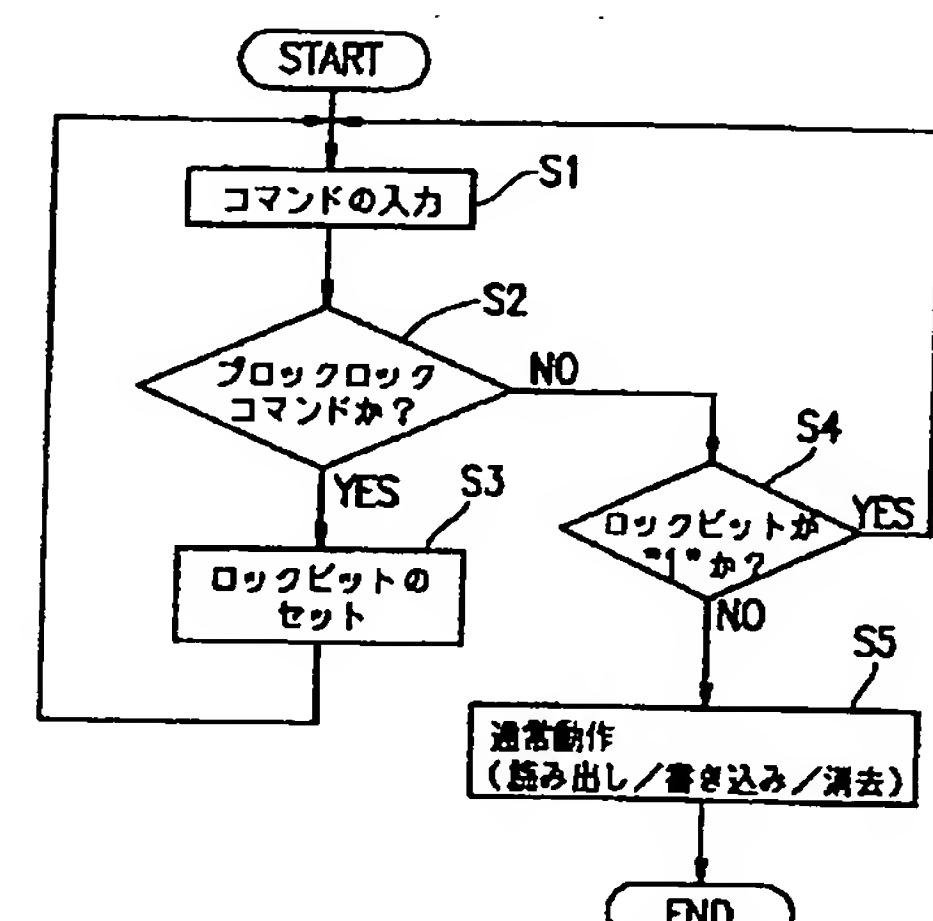
XD (XD<sub>1</sub>, …, XD<sub>k</sub>) 行デコーダ

L (L<sub>1</sub>, …, L<sub>k</sub>) ブロックロック設定部

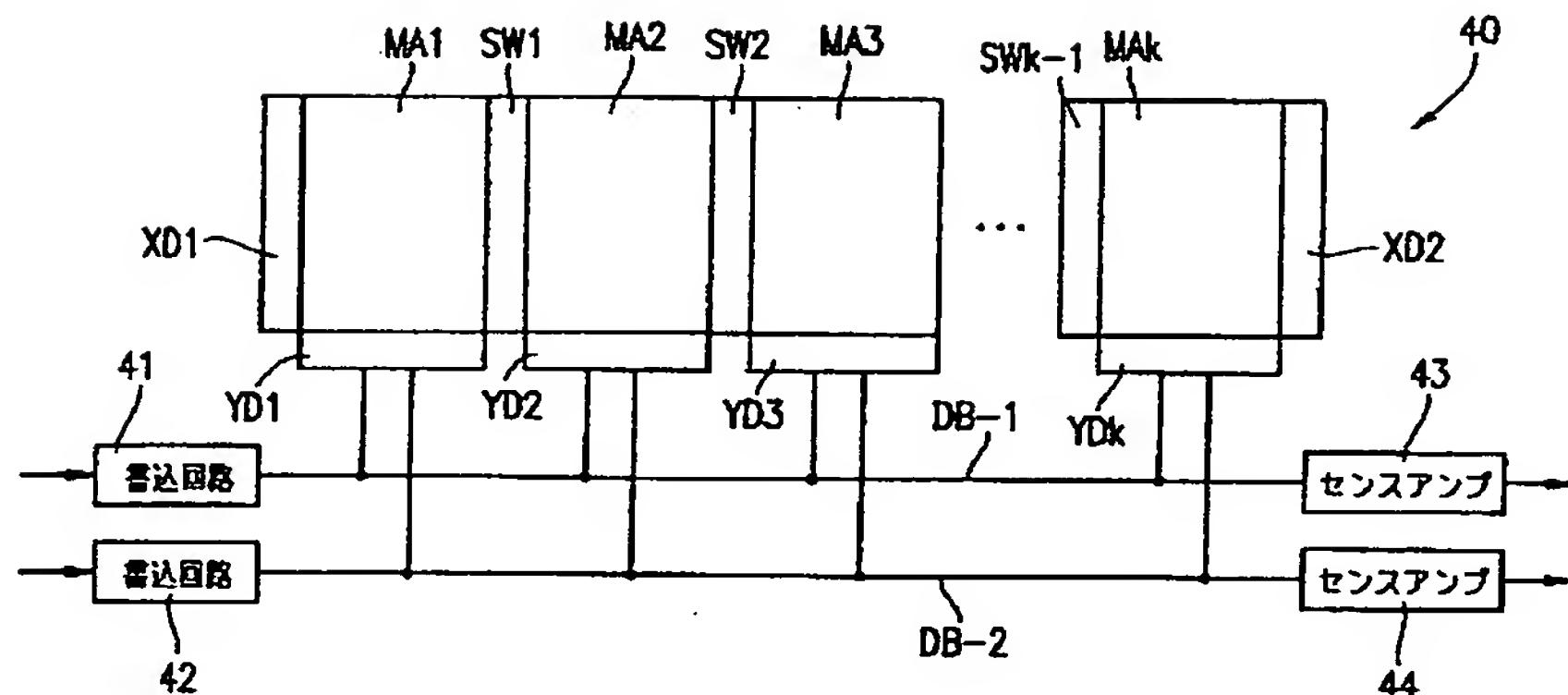
【図1】



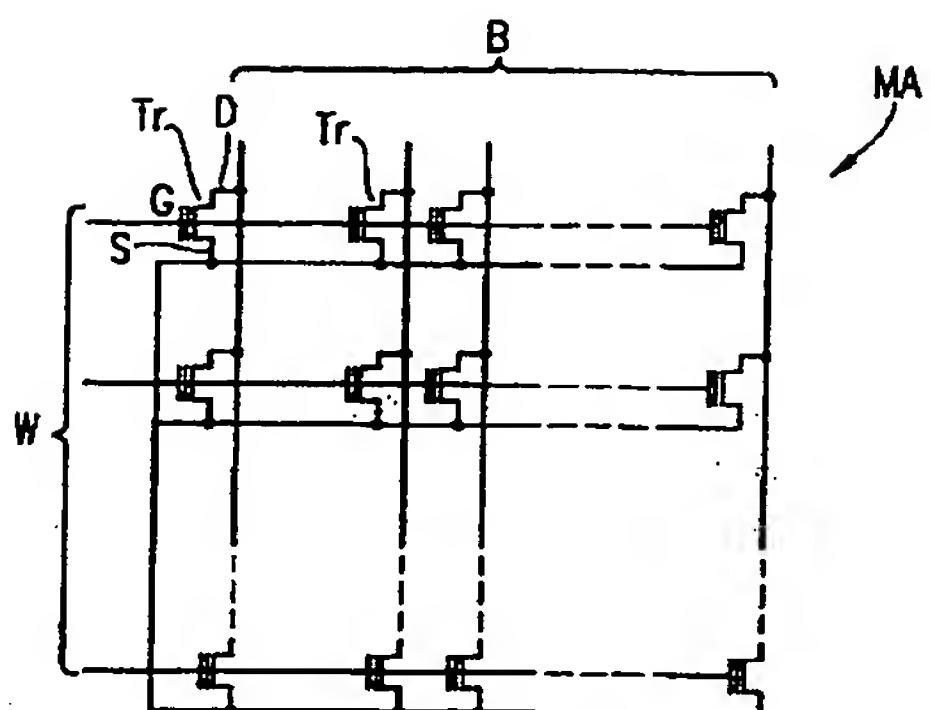
【図2】



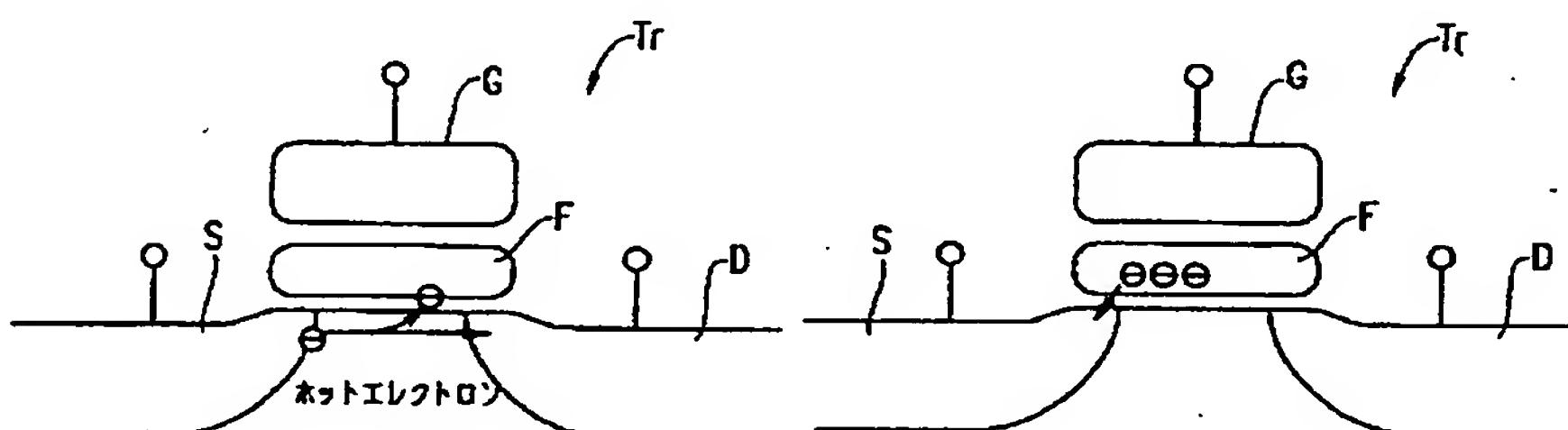
【図 3】



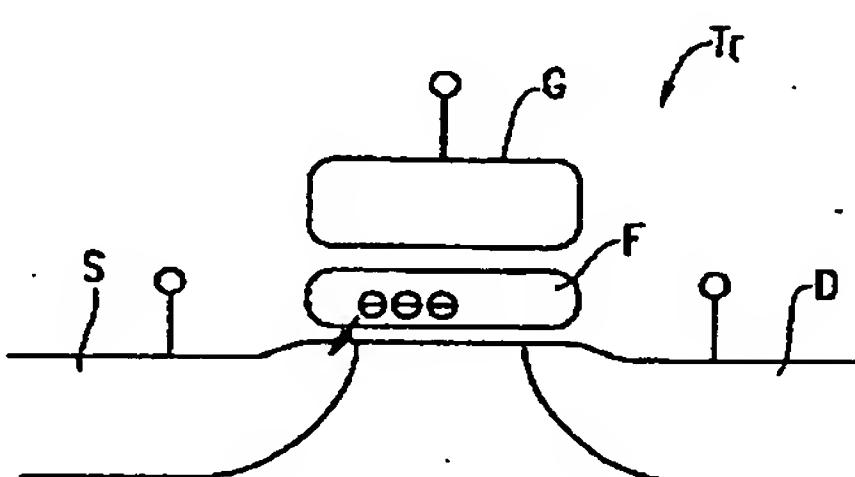
【図 4】



【図 5】



【図 6】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>  
H 01 L 29/792

識別記号

F I

テーマコード(参考)

F ターム(参考) 5B017 AA02 BA04 BB03 BB05 CA11  
CA16  
5B025 AA03 AB01 AC01 AD01 AD14  
AE00 AE08  
5F001 AA01 AB08 AC06  
5F083 EP02 EP22 ER02 ER16 ER23  
ER30  
5F101 BA01 BB05 BC11